
	<h2 style="color: red;">FDB0260N1007L</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FDB0260N1007L</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 100V 200A D2PAK</p> <p>Datenblätter:  FDB0260N1007L.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	








Spezifikationen

Teilenummer	FDB0260N1007L
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V 200A D2PAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	D ² PAK (TO-263)
Serie	PowerTrench®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	2.6 mOhm @ 27A, 10V
Verlustleistung (max)	3.8W (Ta), 250W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-7, D ² Pak (6 Leads + Tab)
Andere Namen	FDB0260N1007LTR
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	39 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	8545pF @ 50V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	118nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 100V 200A (Tc) 3.8W (Ta), 250W (Tc)
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	200A (Tc)

FDB0260N1007L Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FDB0260N1007L-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FDB0260N1007L AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ FDB0260N1007L E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FDB029N06 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 120A D2PAK</p>	 <p>FDB024N08B FAIRCHILD FAIRCHILD TO263-7</p>	 <p>FDB024N08BL7 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 80V 120A D2PAK7</p>	 <p>FDB0300N1007L AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 200A D2PAK</p>
 <p>FDB0250N807L AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 80V 240A D2PAK</p>	 <p>FDB0250N807L Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 80V 240A D2PAK</p>	 <p>FDB0260N1007L Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 200A D2PAK</p>	 <p>FDB024N08BL7 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 80V 120A D2PAK7</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FDB0260N1007L AMI Semiconductor / FDB0260N1007L Datenblatt	FDB0260N1007L-Datenblätter	FDB0260N1007L PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FDB0260N1007L
FDB0260N1007L Electronic	FDB0260N1007L-Komponenten	FDB0260N1007L-Verteiler	FDB0260N1007L-Bild
FDB0260N1007L Preis	FDB0260N1007L Hersteller	FDB0260N1007L Bild	FDB0260N1007L Aktie
FDB0260N1007L Neu	FDB0260N1007L Original	FDB0260N1007L garantiert	FDB0260N1007L RFQ
			FDB0260N1007L Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited